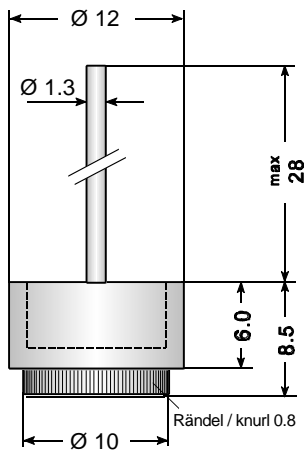


**Fast Si-Press-Fit Diodes**
**Schnelle Si-Einpreßdioden**


Anode to case / Gehäuse  
Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	20 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...200 V
Metal press-fit case with plastic cover Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung	
Weight approx. – Gewicht ca.	10 g
Casting compound has UL classification 94V-0 Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert	

Standard packaging: bulk  
Standard Lieferform: lose im Karton

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
KMSF 70	50	50
KMSF 71	100	100
KMSF 72	200	200

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	20 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	600 A <sup>2</sup> s
Peak forward surge current, single half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	350 A
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	– 50...+200°C – 50...+200°C
Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck			7 kN

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur  $T_j$  – 50...+200°C  
 Storage temperature – Lagerungstemperatur  $T_s$  – 50...+200°C

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 20\text{ A}$	$V_F$	< 1.2 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 10 $\mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to/auf $I_R = 0.25\text{ A}$		$t_{rr}$	< 250 ns
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			$R_{thC}$	< 1 K/W

